## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-274646

(43) Date of publication of application: 08.10.1999

(51)Int.CI.

HOIS GO2B 1/04 **G02B** 5/18 GO2B 6/32 GO2B 6/42 G02B 13/00 G02B 13/18

(21)Application number: 10-073814

(71)Applicant:

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD

(22)Date of filing:

23.03.1998

(72)Inventor:

TANAKA YASUHIRO **ASAKURA HIROYUKI** 

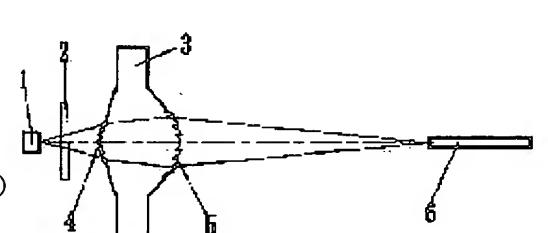
YAMAGATA MICHIHIRO

### (54) PLASTIC LENS AND SEMICONDUCTOR LASER MODULE EMPLOYING IT

#### (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To attain a stabilized optical coupling effect by integrating a diffracting means on the opposite refracting faces of a simple lens such that specified conditions are satisfied when an objective point and an image are located, respectively, on the focus point side and semiconductor side thereby suppressing shift of focus point.

SOLUTION: A plastic lens 3 is a simple lens having nonspherical faces with phase gratings 4, 5 being formed on the incoming and outgoing sides of light and retracted or diffracted light is focused on the end face of an optical fiber 6. When the NAL (number of aperture) on the light intake side of a semiconductor laser is 0.15<NAL<0.5, magnification m of the optical system is 0.2<&verbar;m&verbar;<1 and a diffracting means is integrated on the opposite sides of the refracting face, the ratio between the local length fG and the focal length fP of lens subjected to refraction is set in the range of 0.06<WT.fP/fG<0.135, where WT is fluctuation of wavelength (unit: nm/degree) of the semiconductor laser. Spherical aberration is corrected sufficiently and high coupling effect can be attained.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公輟(A)

## (11)特許出頭公別番号

# 特關平11-274646

(43)公開日 平成11年(1999)10月8日

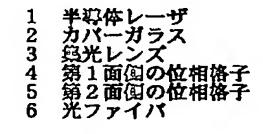
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		微別記号		FΙ				•				
H01S	3/18			H0	1 S	3/18						
G02B	1/04	1		G 0 :	2 B	1/04						
	5/18					5/18						
	6/32					6/32						
	6/42					6/42						
	·		容在請求	未說求	的水道		OL	(全 10	頁)	最終頁に続く		
(21) 出願番号		<b>特頭平10-73814</b>		(71) 出	人製出	000005821						
						松下母器産業株式会社						
(22)出혫日		平成10年(1998) 3月23日						大阪府門真市大字門真1006番地				
				(72)	発明者	田中 麻弘						
				İ		大阪府	門真市	大字門真	〔1006番	地 松下電器		
						產業株	式会社	内				
				(72)	発明者	朝倉	宏之					
						大阪府	門真市	大字門袞	〔1006番	地 松下電器		
						產獎株	式会社	内				
				(72)	発明者	山形	道弘					
						大阪府	門真市	大字門真	〔1006番	地 松下電器		
						產獎株	式会社	内				
				(74)	代理人	弁理士	滝本	智之	外1	. 名)		

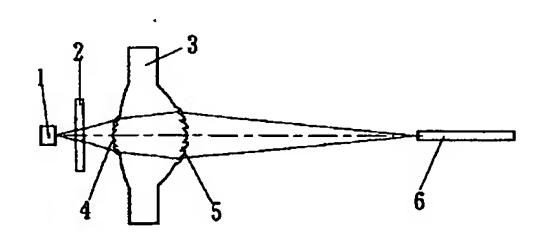
## (54) 【発明の名称】 プラスチックレンズとそれを用いた半導体レーザモジュール

#### (57)【要約】

【課題】 半導体レーザの光を光ファイバに結合させる ためのプラスチックレンズに関し、温度によって低下す る結合効率を実用上十分な範囲内に抑制し安定した結合 効率を得る。またモジュールの光出力を一定基準以下に 抑える。

【解決手段】 プラスチックレンズの温度変化によって 生じる焦点シフトを屈折面に一体化した回折素子によっ て補正し、かつ回折素子のピッチを加工が容易な範囲と する。また回折効率を制御して、焦点面にアパーチャを 設けることで、モジュールの光出力を抑制する。





#### 【特許請求の範囲】

, t

【請求項1】 半導体レーザと半導体レーザの出射光を 集光するプラスチックレンズとからなる半導体レーザモ ジュールの光学系において、前記プラスチックレンズは 少なくとも1面が非球面からなる単レンズであって、前 記単レンズの両方の屈折面に回折手段を一体化し、集光 点側を物点、半導体レーザ側を像点としたとき、以下の ・条件を満足するプラスチックレンズ。

 $0.15 < NA_1 < 0.5$  (1)

 $0. \ 2 < |m| < 1 \tag{2}$ 

0.  $0.6 < W_{\tau} \cdot f_{r} / f_{c} < 0.135$  (3) ただし

NA、: 単レンズの半導体レーザ側(像点側)のNA (開口数)

m:倍率

f。: 回折素子の総合焦点距離でf。= 1/f。1+1/f こで表す。ただし、

fc1:物点側の面に一体化された回折レンズの焦点距離

faz:像点側の面に一体化された回折レンズの焦点距離

f。: 単レンズの屈折作用によるレンズの焦点距離

₩₁:半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単

位:nm/度)

【請求項2】 半導体レーザと半導体レーザの出射光を 集光するプラスチックレンズとからなる半導体レーザモ ジュールの光学系において、前記プラスチックレンズは 少なくとも1面が非球面からなる単レンズであって、前 記単レンズの片方の屈折面に回折手段を一体化し、集光 点側を物点、半導体レーザ側を像点としたとき、以下の 条件を満足するプラスチックレンズ。

 $0.15 < NA_{\iota} < 0.5$  (4)

1/5 < |m| < 1(5)

0.  $0.2 < W_{\tau} \cdot f_{r} / f_{c} < 0.12$ (6) ただし

NA、: 単レンズの半導体レーザ側(像点側)のNA (開口数)m:倍率

f。: 片方の面に一体化された回折レンズの焦点距離

f<sub>p</sub>: 単レンズの屈折作用によるレンズの焦点距離

₩τ:半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単 位:nm/度)

【請求項3】 前記回折手段は輪帯状の位相格子である 40 ールホルダ27とにより着脱自在に固定される。 ことを特徴とする請求項1または2に記載のプラスチッ クレンズ。

【請求項4】 前記回折手段の1次回折光を用いたこと を特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記載のブ ラスチックレンズ。

【請求項5】 前記回折手段の2次以上の回折光を用い たことを特徴とする請求項1から3のいずれか1項に記 戯のプラスチックレンズ。

【請求項6】 光ファイバと光ファイバの入射端を固定 する固定手段とレーザ光を発振する半導体レーザと、前 50 ザモジュールからの光出力を一定基準以下に制限するた

記半導体レーザからのレーザ光を前記光ファイバの入射 端に結像するプラスチックレンズとからなり、前記プラ スチックレンズは請求項1から4のいずれか1項に記載 されたものである半導体レーザモジュール。

【請求項7】 光ファイバと光ファイバの入射端を固定 する固定手段とレーザ光を発振する半導体レーザと、前 記半導体レーザからのレーザ光を前記光ファイバの入射 端に結像するプラスチックレンズとからなり、前記プラ スチックレンズは請求項1から4のいずれか1項に記載 10 されたものであり、前記光ファイバの入射端にアパーチ ャ部材を設けたことを特徴とする半導体レーザモジュー ル。

【請求項8】 前記プラスチックレンズは前記光ファイ バの入射端を固定する固定手段と、前記半導体レーザを 固定する固定手段を兼ねるよう一体に成形されたことを 特徴とするプラスチックレンズ。

【請求項9】 前記プラスチックレンズは前記光ファイ バの入射端を固定する固定手段と、前記半導体レーザを 固定する固定手段を兼ねるよう一体に成形されたことを 20 特徴とする請求項5または6に記載の半導体レーザモジ ュール。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、光通信や光計測等 に用いられ、半導体レーザのレーザ光を光ファイバに結 合するプラスチックレンズとそれを用いた半導体レーザ モジュールに関する。

[0002]

【従来の技術】光通信に用いられる半導体モジュールに 30 おいて、半導体レーザまたは光受光素子と光ファイバと を効率よく結合させることが求められている。従来の半 **導体レーザモジュールについて図11を用いて説明す** る。図11は従来の半導体レーザモジュールの構成例を 示す断面図である。従来のレーザモジュールはレンズホ ルダー24に半導体レーザ23と、集光レンズ25が固 定されている。さらにレンズホルダ24は接続用ホルダ 26に挿入される。との接続用ホルダ26に対して、光 ファイバ28の入射端部が固定される。光ファイバ28 を挿入するフェルール29と、フェルール固定用フェル

【0003】集光レンズ25はガラス製の非球面レンズ である。半導体レーザ23から出た光30は集光レンズ 25で光ファイバ28の端面に集光され、ファイバに結 合される。集光レンズとしては低コスト化のためプラス チック非球面レンズが使用される場合もある。(たとえ ば特開平5-60952号公報、特開昭61-2455 94号公報、特開平5-27140号公報、特開平5-60940号公報等)。

【0004】また、取り扱い上の安全性の点から、レー

3

めに、光ファイバがはずれた場合に、自動的に発光を停 止する機能を有するものやモジュールからの出力を光学 的に制限するものがある。

[0005]

, i 1

【発明が解決しようとする課題】このような従来のレー ザモジュールでは非球面レンズを使用する場合、ガラス 非球面レンズは髙価でありレーザモジュールのコストが \* 髙くなってしまう。またプラスチックの非球面レンズで は、熱膨張係数がガラスと比較して大きく、またプラス チック材料の屈折率が温度によって変化する。このため 10 プラスチックレンズを使用すると、温度の変化に伴って 半導体レーザ発振器とレンズ間距離を固定した場合、焦 点距離すなわち光ファイバ方向の結像位置が変化すると とになる。

【0006】たとえばレーザと光ファイバ間距離が10 mm、倍率が3倍のプラスチックレンズの場合、温度に よる焦点移動は8μm/degとなる。したがって、レ ーザモジュールでは半導体レーザ発振器、レンズ、光フ ァイバがいずれも固定されているために、光ファイバへ の結合効率が温度と共に変化してしまう。通常は常温に 20 チックレンズの焦点距離が変化する分を、波長が変化す おいて調整組立されるために、レーザモジュールの高温 動作や低温動作では光ファイバからの出力が低下してし まう。

【0007】さらに回折素子をプラスチックレンズに一米

 $V_{\tau} = (n_{0.790} - 1) / (n_{-50.780} - n_{.50.800})$  (7)

となる。ここで常温時の屈折率を1.5とすると、

(7)式の分子は±50度での屈折率差で0.009と※

$$V_{c} = 790 / (780 - 800) = -39.5$$
 (8)

となる。ここで、プラスチックレンズの焦点距離変化を 回折素子で完全に補正するためには、プラスチックレン 30 著しく困難であるなどの問題があった。 ズの焦点距離をf。、回折素子の焦点距離をf。とする と、

 $1/(f_{P} \cdot V_{T}) + 1/(f_{G} \cdot V_{G}) = 0$  (9) を満たす必要がある。すなわち(9)式から、f。/f。  $=-V_{c}/V_{r}=0$ . 711となる必要がある。つまりV ィとV。の絶対値はほぼ同じ程度の大きさであるため、f ,とfcもほぼ同じ焦点距離である必要がある。この点は 従来の回折素子を一体化した色消しレンズでは回折素子 **のパワーが屈折素子のパワーより 1 桁以上小さくて良い** 点とは大きく異なる。

【0010】半導体レーザモジュールでは、半導体レー ザから出た光を効率よく取り込むために、半導体レーザ 側のNAは通常0.3程度である。このレンズを達成す るためにプラスチックレンズと回折レンズが同じパワー を持っているとすると、回折レンズに必要なNAは0. 15程度となる。回折レンズの最小ピッチdu。は、ほ ぼNAと波長λによって決まり、

 $d_{pin} = \lambda / NA$ (10)

となる。例としてNAが0.15、波長が800nmと すると、最小ピッチdω。は、5.3μmと非常に小さ

\* 体化し、半導体レーザの波長変動を利用してプラスチッ クレンズの焦点距離が変化しないようにした場合につい て考察する。たとえばプラスチックレンズとして屈折率 の温度に対する変化量は約-8.5×10<sup>-1</sup>程度であ る。温度変化が±50度であるとプラスチックレンズの 屈折率変化は±0.004255となる。

【0008】一方半導体レーザの温度変化に対する波長 変動を0.2mm/度とすると温度変化が同様に±50 度として半導体レーザの波長は±10nm変化する。半 導体レーザの中心波長が790nmであれば、780n mから800nmまで変化することになる。常温におけ る中心波長での屈折率を n。、、。。とすると、温度が常温 -50度のときの屈折率は波長が780nmになるの で、n-50,780、温度が常温+50度のときの屈折率は 波長が800mmになるので、 n.so.sooと表すことに し、温度による屈折率変化と、波長の変化による屈折率 変化を総合すると、±50度でのプラスチックレンズの 屈折率変化は±0.0045程度となる。

【0009】温度により屈折率が変化することでプラス るととによる回折素子の焦点距離変化で補正する場合に 必要なそれぞれの素子のパワーについて計算する。回折 素子の焦点距離は屈折率変化には依らない。温度変化が ±50度の場合、プラスチックレンズの分散V<sub>T</sub>は

※なりV<sub>τ</sub>=55.56となる。回折素子の分散V<sub>c</sub>は

くなる。回折素子のピッチが小さくなりすぎると加工が

【0011】また、半導体レーザモジュールは取り扱い 状の安全性の点から、レーザモジュールからの光出力を ′一定基準以下に制限するための機能を付加しなければな らないため、構造が複雑になりコストが上昇する。光フ ァイバのはずれの検出をして発光を停止するためには制 御回路が必要になる。光学的に光量を制約する方法とし てアパーチャーによって光量を制限する方法があり、ア パーチャーが、集光レンズを通過するレーザー光を制限 するために設けられる。しかし、この方法は、アパーチ 40 ャーの面積によって透過率を制約するために、レーザの 射出角のばらつきによる特性ばらつき、アパーチャーの 加工に高い精度が要求される。また位置調整などの組立 工数の増加が発生する。これらはいずれもコストの増加 を伴うものであった。

【0012】本発明は上記問題点に鑑み、レーザモジュ ール内の温度変化による半導体レーザの発振波長の変化 やプラスチックレンズの光学特性の変化に対応して、結 像位置の移跡の少ない安定な光結合効率が得られ、かつ 作り易いプラスチックレンズを提供するとともに、その 50 レンズを用いて、温度特性が良く、低コストでレーザモ

ジュールからの出力光を一定値以内に制約する半導体レ ーザモジュールを提供することを目的とするものであ る。

[0013]

1

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するた め、本発明のプラスチックレンズは、半導体レーザと半 導体レーザの出射光を集光するプラスチックレンズとか <sup>2</sup> らなる半導体レーザモジュールの光学系において、前記 プラスチックレンズは少なくとも1面が非球面からなる 単レンズであって、前記単レンズの両方の屈折面に回折 10 手段を一体化し、集光点側を物点、半導体レーザ側を像 点としたとき、以下の条件を満足することを特徴とする ように構成されている。

$$[0014]0.15 < NA_{l} < 0.5$$
 (1)  
 $0.2 < |m| < 1$  (2)

0.2 < |m| < 1

0.  $0.6 < W_T \cdot f_r / f_s < 0.135$  (3)

ただし

NA、: 単レンズの半導体レーザ側(像点側)のNA (開口数)

m:倍率

f。:回折素子の総合焦点距離でf。=1/f。1+1/f こで表す。ただし、

f。:物点側の面に一体化された回折レンズの焦点距離 fcx:像点側の面に一体化された回折レンズの焦点距離

f,:単レンズの屈折作用によるレンズの焦点距離

Wr:半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単

位: n m/度)

また本発明の別のプラスチックレンズは、半導体レーザ と半導体レーザの出射光を集光するプラスチックレンズ とからなる半導体レーザモジュールの光学系において、 前記プラスチックレンズは少なくとも1面が非球面から なる単レンズであって、前記単レンズの片方の屈折面に 回折手段を一体化し、集光点側を物点、半導体レーザ側 を像点としたとき、以下の条件を満足する。

$$[0015]0.15 < NA_{L} < 0.5$$
 (4)  
0.  $2 < |m| < 1$  (5)

0.  $0.2 < W_{\tau} \cdot f_{r} / f_{s} < 0.12$  (6)

NA、: 単レンズの半導体レーザ側(像点側)のNA (開口数)

m:倍率

ただし

f<sub>a</sub>: 片方の面に一体化された回折レンズの焦点距離

f.: 単レンズの屈折作用によるレンズの焦点距離

Wr:半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単

位: n m/度)

上記構成において、回折手段は輪帯状の位相格子である ととが望ましい。

【0016】また、回折手段は1次回折光を用いること が望ましい。さらに、回折手段は2次以上の回折光を用 いることが望ましい。

【0017】一方、本発明の光ヘッド装置は、光源と、 前記光源から出射された光線を情報媒体面上に集光する 集光手段と、前記情報媒体で変調された光束を分離する ための光束分離手段と、前記情報媒体で変調された光を 受光する受光手段を具備し、前記集光手段は上記各構成 のいずれかに記載されたものである。

【0018】一方、本発明の半導体レーザモジュール は、光ファイバと光ファイバの入射端を固定する固定手 段とレーザ光を発振する半導体レーザと、前記半導体レ ーザからのレーザ光を前記光ファイバの入射端に結像す るプラスチックレンズを具備し、前記プラスチックレン ズは上記各構成のいずれかに記載されたものである。

【0019】また、本発明の別の半導体レーザモジュー ルは、光ファイバと光ファイバの入射端を固定する固定 手段とレーザ光を発振する半導体レーザと、前記半導体 レーザからのレーザ光を前記光ファイバの入射端に結像 するプラスチックレンズを具備し、前記プラスチックレ ンズは上記各構成のいずれかに記載されたものであり、 前記光ファイバの入射端に不要な回折光をの透過を制限 20 するアパーチャ部材を設けたことを特徴とするものであ る。

【0020】また本発明の別の半導体レーザモジュール は、光ファイバの入射端を固定する固定手段を兼ねるよ う一体に成形されたととを特徴とするプラスチックレン ズを用いたものである。

[0021]

が困難となる。

【発明の実施の形態】以上のように、本発明のプラスチ ックレンズは単レンズであるから光学系がシンプルであ り、また少なくとも1面に非球面を用いることで、球面 30 収差を十分に補正し高い結合効率を得ることができる。 さらに、半導体レーザの光を取り込む側のNA、を

 $0.15 < NA_1 < 0.5$  (1) の範囲にする必要がある。この範囲の下限を越えると半 導体レーザの光を十分に取り込むことができなくなる。 またこの範囲の上限を越えても半導体レーザの光を取り 込む量はほとんど増えず、逆に収差性能を満足すること

【0022】また光学系の倍率mを

0.2 < |m| < 1 (2)

40 の範囲に限定する必要がある。この範囲の下限を越える と、光ファイバ側のスポット径が大きくなりすぎ、結合 効率が得られなくなる。一方この範囲に上限を越えると 位置決め精度が厳しくなりすぎて組立調整が困難とな る。

【0023】さらに、回折手段を屈折面の両面に一体化 し、その焦点距離f。と屈折によるレンズの焦点距離f, との比を

0.  $0.6 < W_T \cdot f_P / f_S < 0.135$  (3) の範囲にする必要がある。ただし

50 f<sub>c</sub>:回折素子の総合焦点距離でf<sub>c</sub>=1/f<sub>c1</sub>+1/f

こで表す。ただし、

f c1:物点側の面に一体化された回折レンズの焦点距離 f c2:像点側の面に一体化された回折レンズの焦点距離

7

f。: 単レンズの屈折作用によるレンズの焦点距離

Wr:半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単

位:nm/度)

この範囲の下限を越えると温度変化に対して焦点の移動 - 量が大きくなりすぎ、結合効率が悪化してしまう。この 範囲の上限を越えると、回折素子のピッチが小さくなり すぎて作り難いレンズとなってしまう。

【0024】本発明の別のプラスチックレンズでは、片面のみに回折手段を一体化しても、先に述べた理由と同様にして以下の条件を満足する必要がる。

 $[0025]0.15 < NA_1 < 0.5$  (4)

0.2 < |m| < 1

(5)

0.  $02 < W_{\tau} \cdot f_{r} / f_{c} < 0. 12$  (6)

ただし

NA<sub>L</sub>:単レンズの半導体レーザ側(像点側)のNA (開口数)m:倍率

f<sub>c</sub>: 片方の面に一体化された回折レンズの焦点距離

f<sub>e</sub>: 単レンズの屈折作用によるレンズの焦点距離

₩τ:半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単

位: n m/度)

以下に各実施例の具体的な数値例を示す。各実施例において共通な仕様として、設計の中心波長は790nmとした。また、集光点側を物点、半導体レーザ側を像点とし、物点とプラスチックレンズの間には、厚み0.3mm、屈折率1.48のカバーガラスが入るものとする。またレンズの物点側すなわち光ファイバ側の面を第1面、像面側すなわち半導体レーザ側の面を第2面とする。以下の各実施例において、

f:レンズの総合焦点距離

f,:屈折作用のみによるレンズの焦点距離

f<sub>61</sub>:第1面に一体化された回折レンズの焦点距離 f<sub>62</sub>:第2面に一体化された回折レンズの焦点距離 ただしf<sub>61</sub>.f<sub>62</sub>いずれかの数値が0のときは、その面 に回折素子が一体化されていないことを意味する。

【0026】f。: 回折作用のみによるレンズの焦点距離で以下の式により求める。

 $f_{c} = 1 / f_{c1} + 1 / f_{c2}$ 

ただしf。1、f。2いずれかの数値が0のときは、0でない方の数値がf。と等しいとする。

【0027】NA<sub>L</sub>:レンズの半導体レーザ側(像点側)のNA(開口数)

m:倍率

R1:レンズの第1面の曲率半径

R<sub>1</sub>:レンズの第2面の曲率半径

d:レンズの中心厚み

n:レンズの屈折率

IO:物点から像点での距離

非球面形状は以下の(数1)で与えられる。

[0028]

【数1】

$$x = \frac{C j h^{2}}{1 + \sqrt{1 - (1 + CC j)C j^{2}h^{2}}} + \sum_{j_{n}} A_{j_{n}} h^{n}$$

8

【0029】X:光軸からの高さがhの非球面上の点の 非球面頂点の接平面からの距離

h:光軸からの高さ

10 C<sub>1</sub>:レンズの第1面の非球面頂点の曲率(C<sub>1</sub>=1/R<sub>1</sub>)

 $C_1$ : レンズの第2面の非球面頂点の曲率( $C_1 = 1/R$ <sub>1</sub>)

CC1:レンズの第1面の円錐定数

CC2: レンズの第2面の円錐定数

Aln:対物レンズの第1面のn次の非球面係数

A2n:対物レンズの第2面のn次の非球面係数である。

【0030】また位相格子は超高屈折率法(参考文献と 20 して例えばウィリアム シー スウェット、ディスクライビング ホログラフィック オプティカル エレメントアズ レンジーズ (ホログラフィック光学素子のレンズとしての記述) ジャーナル オブ オプティカル ソサエティ オブ アメリカ、第67巻、ナンバー6、1997年) によって表現した。位相格子を表す非球面形状は通常の非球面形状と同じ(数1)で表し、

Cd1:レンズの第1面に一体化した位相格子を表す非 球面の非球面頂点の曲率(Cd1=1/Rd1)

CCd1:レンズの第1面に一体化した位相格子を表す

30 非球面の円錐定数

Ad1, n:レンズの第1面に一体化した位相格子を表す非球面のn次の非球面係数

nd1:レンズの第1面に一体化した位相格子を表す超高屈折率

Cd2:レンズの第2面に一体化した位相格子を表す非球面の非球面頂点の曲率(Cd2=1/Rd2)

CCd2:レンズの第2面に一体化した位相格子を表す 非球面の円錐定数

Ad2, n:レンズの第2面に一体化した位相格子を表 40 す非球面のn次の非球面係数

nd2:レンズの第2面に一体化した位相格子を表す超 高屈折率

位相格子とレンズの間隔はいずれも0とした。

【0031】またレンズの各性能を以下のように表す。

W<sub>r</sub>: 半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単位: n m/度)

実施例ではすべて半導体レーザの温度変化による波長変助を0.2 nm/度とした。このとき各温度における波長、レンズの屈折率、位相格子を表す超高屈折率は以下

50 に示す値でレンズ性能を計算した。

10

[0032]

温度 波長 レンズの屈折率 超高屈折率 常温-50度 780nm 常温の屈折率+0.00449 7801 常温+50度 800nm 常温の屈折率-0.00449 8001

TV:レンズの単位温度あたりの焦点位置の変動量(単

位 μm/度)

Wa:レンズの軸上のRMS波面収差(単位 λ:波 - 長)

【0033】(実施例1)実施例1では、両面非球面対物レンズの両面に位相格子を設けている。

[0034] f = 1.5239

 $f_{P} = 2.1545$ 

 $f_{G1} = 7.97268$ 

 $f_{G2} = 6.03643$ 

 $f_{c} = 3.43538$ 

 $NA_{L} = 0.3$ 

m = -0. 3333

 $R_1 = 1.51187$ 

 $R_z = -2.92298$ 

d = 1.5

n = 1.523306

IO = 8.500

 $CC_1 = -3.08003 \times 10^{-1}$ 

 $A1_4 = -2.24944 \times 10^{-2}$ 

 $CC_2 = -2.13087$ 

 $A2_4 = 3.71374 \times 10^{-2}$ 

位相格子のパラメータは以下の通りである。

[0035] Rd1=1. 51183371

 $CCd1 = -3.07979 \times 10^{-1}$ 

Ad 1, 4 = -2. 24962×10<sup>-2</sup>

Ad 1,  $_{5} = -1$ . 58024×10<sup>-6</sup>

Ad 1,  $s = 1.72288 \times 10^{-7}$ 

n d 1 = 7901

Rd2 = -2.92280085

CCd2 = -2.13127

Ad 2,  $= 3.71376 \times 10^{-2}$ 

Ad 2,  $_{6} = -3$ .  $68097 \times 10^{-6}$ 

Ad 2, = 5.  $42599 \times 10^{-6}$ 

nd2=7901

 $W_{\tau} = 0.2$ 

またレンズの性能を表すパラメータは以下の通りであ

る。

 $[0036]W_{\tau} \cdot f_{\rho}/f_{c} = 0.1254$ 

TV = 0.529

Wa = 0.0002

図2に実施例1の収差図を示す。図3に本発明の位相格 (n-1)の鋸歯状である。ただしλは光源の波長、n は屈折率である。との場合、ピッチが波長より十分に大 きい場合は、スカラー解析が適用できて、回折効率は1 00%となる。図3(b)は高さが2 λ/(n-1)の 鋸歯状であり、ピッチは、先ほどの2倍になる。この場 合、2次回折光に対して回折効率が100%となる。ビ ッチが2倍になるため、作成が容易となる。実施例1に 2次回折光を用いると、第1面側の同心円上の回折格子 の数は13、第2面側の同心円上の回折格子の数は9で 20 あり、格子の最小ピッチは25μmと十分に加工可能な 大きさとなっている。図3 (c)には高さがλ/(n-1)の鋸歯状で、ピッチが図3(b)と同じ物を示す。 図3(b)よりも相対的に高さが半分になてっいる。こ の場合回折効率は50%となる。位相格子の高さを変え ることで、回折効率を変え、光量を制限するフィルター の機能を持たすことができる。

【0037】次に第2の実施例について説明する。図4は、本発明のプラスチックレンズの実施例2に対応する構成を示す光路図である。図4において、半導体レーザ30 1から出射した光はプラスチックレンズ7に入射する。プラスチックレンズ7は両面非球面の単レンズであり、光ファイバ側の面に位相格子9が形成されており、半導体レーザ側の面8は、非球面のみである。プラスチックレンズ7で、屈折及び回折された光は光ファイバ6の端面に集光される。

【0038】(実施例2)実施例2では、両面非球面対物レンズの第1面にのみ位相格子を設けている。

[0039] f = 1.0929

 $f_r = 1.35584$ 

40  $f_{G1} = 4.0000$ 

 $f_{G2} = 0$ 

 $f_{G} = 4.0000$ 

 $NA_{L} = 0.23$ 

m = -0.66667

 $R_1 = 1.25700$ 

 $R_z = -1.183841$ 

d = 1.0

n = 1.523306

10 = 4.8558

50  $CC_1 = 7.44535 \times 10^{-1}$ 

11

 $A1_{4} = 2.43250 \times 10^{-2}$  $A 1_6 = -2.62887 \times 10^{-1}$  $A1_{s} = -1.79167 \times 10^{\circ}$  $Al_{10} = 4.45550 \times 10^{\circ}$ 

 $CC_1 = -9.72684 \times 10^{-1}$ 

 $A2_{4} = 3.79205 \times 10^{-1}$ 

 $A2_{6} = -3.87138 \times 10^{-1}$ 

 $^{-}$  A 2  $_{s} = -3$ . 16389×10°

 $A2_{10} = 9.42199 \times 10^{\circ}$ 

位相格子のパラメータは以下の通りである。

[0040] Rd1=1. 25695

 $CCd1 = 7.44414 \times 10^{-1}$ 

Ad 1, = 2. 43133×10<sup>-2</sup>

Ad 1,  $_{6} = -2$ . 62850×10<sup>-1</sup>

Ad 1, s = -1. 79187×10°

Ad 1,  $_{10} = 4.45597 \times 10^{\circ}$ 

n d 1 = 7901

 $W_{\tau} = 0.2$ 

またレンズの性能を表すパラメータは以下の通りであ る。

 $[0041]W_{\tau} \cdot f_{\rho}/f_{c} = 0.0678$ 

TV = 0.341

Wa = 0.0017

図5に実施例2の収差図を示す。

【0042】次に第3の実施例について説明する。図6 は、本発明のプラスチックレンズの実施例3に対応する 構成を示す光路図である。図6において、半導体レーザ 1から出射した光はカバーガラス2を透過してプラスチ ックレンズ10に入射する。プラスチックレンズ10は 位相格子11が形成され、光ファイバ側の面12は非球 面のみである。プラスチックレンズ10で、屈折及び回 折された光は光ファイバ6の端面に集光される。

【0043】(実施例3)実施例3では、両面非球面対 物レンズの第2面にのみ位相格子を設けている。

 $\{0044\} f = 1.6013$ 

 $f_{P} = 1.8000$ 

 $f_{G1} = 0$ 

 $f_{G2} = 9.52347$ 

 $f_{c} = 9.52347$ 

 $NA_{L} = 0.25$ 

m = -0.500

 $R_1 = 1.200$ 

 $R_1 = -2.875542$ 

d = 1.2

n = 1.523306

10 = 7.5911

 $CC_1 = -3.90529 \times 10^{-1}$ 

 $A1 = -3.91236 \times 10^{-2}$ 

 $Al_6 = 1.70450 \times 10^{-2}$ 

12

 $A1_{s} = -1. 31011 \times 10^{-2}$ 

 $CC_{1} = -1.71190 \times 10^{\circ}$ 

 $A2_4 = 7.92178 \times 10^{-3}$ 

 $A2_6 = -7.92056 \times 10^{-2}$ 

 $A2_{s} = 4.26057 \times 10^{-3}$ 

 $A2_{10} = -1.89837 \times 10^{-1}$ 

位相格子のパラメータは以下の通りである。

[0045]Rd2 = -2.8754321

CCd2 = -1.71167

10 Ad2,  $= 7.92200 \times 10^{-2}$ 

Ad 2,  $_{6} = -7.91972 \times 10^{-2}$ 

Ad2,  $s = 4.25926 \times 10^{-2}$ 

Ad 2,  $_{10} = -1$ . 89837×10<sup>-1</sup>

nd2 = 7901

 $W_r = 0.2$ 

またレンズの性能を表すパラメータは以下の通りであ る。

 $[0046]W_{\tau} \cdot f_{r}/f_{c} = 0.0378$ 

TV = 1.499

20 Wa = 0.0006

図7に実施例3の収差図を示す。

【0047】次に上記本発明のプラスチックレンズを用 いた半導体レーザモジュールの構成図を図8に示す。レ ンズホルダ13の後端部側に、半導体レーザ14が挿入 されて固定されている。一方、レンズホルダ13の前端 部に集光レンズ15が固定されている。レンズホルダ1 3の外周面には、接続用ホルダ16がはめ込まれてい る。さらに、この接続用ホルダ16に対して、光ファイ バ17の入射端部が固定される。 との例では、光ファイ 両面非球面の単レンズであり、半導体レーザ側の面には 30 パ17を挿入するフェルール18と、フェルール固定用 フェルールホルダ19とにより着脱自在に固定される。 【0048】集光レンズ15はプラスチック製の非球面 レンズであり、その両面に回折素子が一体化されてい る。半導体レーザ14から出た光20は集光レンズ15 で光ファイバ17の端面に集光され、ファイバに結合さ れる。

> 【0049】集光レンズはプラスチックレンズである が、回折素子が一体化されており、プラスチックレンズ の焦点シフトを半導体レーザの波長変動による回折素子 40 の焦点変動でうち消しているため、半導体レーザモジュ ール全体の温度が変化しても、その焦点位置の移動は抑 制され、光ファイバへの結合効率の低下は必要な範囲内 に収まる。

【0050】次に上記本発明のプラスチックレンズを用 いた別の半導体レーザモジュールの構成図を図9に示 す。レンズホルダ13の後端部側に、半導体レーザ14 が挿入されて固定されている。一方、レンズホルダ13 の前端部に集光レンズ15が固定されている。レンズホ ルダ13の外周面には、接続用ホルダ16がはめ込まれ

50 ている。さらに、この接続用ホルダ16に対して、光フ

ァイバ17の入射端部が固定される。この例では、光フ ァイバ17を挿入するフェルール18と、フェルール固 定用フェルールホルダ19とにより着脱自在に固定され る。フェルール18の端面には、アパーチャ21が設置 される。集光レンズ15の光ファイバ17の端面に集光 するよう設計された回折光、たとえば1次回折光は、ア パーチャ21を透過して光ファイバに結合する。他の次 数の回折光たとえば0次回折光23は光ファイバーの端 面には集光しないためアパーチャ21で光線がけられ る。したがって光ファイバーを着脱したときに半導体レ 10 ーザモジュールから漏れる光量は安全基準内に抑える必 要があるが、従来のように、集光レンズにNDフィルタ ーをコーティングしたり、安全回路を設けたりする必要 がない。

【0051】次に上記した集光レンズと、半導体レーザ と光ファイバを固定するホルダーを一体化した別の半導 体レーザモジュールの構成図を図10に示す。半導体レ ーザ14とフェルールホルダ24は、ホルダー部を一体 化した集光レンズ25の両端面にそれぞれ保持される。 これにより従来の金属鏡筒が不要になり、組立調整が大 20 いに簡素化される。

【0052】なお、半導体レーザは、温度によってレー ザ光の発振波長が変化するものであればよく、たとえ ば、波長1.2~1.6 μm帯のInP系材料の長波長レ ーザ、0.98μm帯の半導体レーザ、発振波長0.78 μm帯のGaAsAl 系材料のレーザなどが利用でき る。発振波長が温度によってシフトするものであれば限 定はされない。

【0053】さらに、1種類のプラスチック材料につい て説明したが、特性の異なるプラスチック材料を用いて 30 Wr: 半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単 も良い。

【0054】また回折格子の形状については鋸歯状とし たが、それ以外の形状であってもよい。

[0055]

. . .

【発明の効果】以上のように、本発明のプラスチックレ ンズは、半導体レーザと半導体レーザの出射光を集光す るプラスチックレンズとからなる半導体レーザモジュー ルの光学系において、前記プラスチックレンズは少なく とも1面が非球面からなる単レンズであって、前記単レ 物点、半導体レーザ側を像点としたとき、

 $0.15 < NA_{L} < 0.5$ (1)

0.2 < |m| < 1(2)

0.  $0.6 < W_T \cdot f_F / f_G < 0.135$  (3) ただし

NA、: 単レンズの半導体レーザ側(像点側)のNA (開口数)

m:倍率

 $f_c:$  回折素子の総合焦点距離で  $f_c=1/f_{c1}+1/f$ こで表す。ただし、

f<sub>61</sub>:物点側の面に一体化された回折レンズの焦点距離 faz:像点側の面に一体化された回折レンズの焦点距離

f。: 単レンズの屈折作用によるレンズの焦点距離

₩,: 半導体レーザの単位温度あたりの波長変動(単

位:nm/度)

の条件を満足するように構成したので、安価なプラスチ ックレンズを用いても、温度変化に対して結合効率の低 下が少なく、環境に対して安定した半導体レーザモジュ ールを提供することができる。また集光レンズに一体化 した回折素子のビッチが十分に大きく加工が容易であ る。さらに非球面を用いているため、スポットが十分に 集光され高い結合効率を得ることができる。また半導体 レーザ側のNAが十分にあり、同じく高い結合効率を得 るととができる。

【0056】また別の本発明のプラスチックレンズは、 半導体レーザと半導体レーザの出射光を集光するプラス チックレンズとからなる半導体レーザモジュールの光学 系において、前記プラスチックレンズは少なくとも1面 が非球面からなる単レンズであって、前記単レンズの片 方の屈折面に回折手段を一体化し、集光点側を物点、半 導体レーザ側を像点としたとき、

 $0.15 < NA_1 < 0.5$  (4)

0.2 < |m| < 1 (5)

0.  $0.2 < W_{\tau} \cdot f_{P} / f_{G} < 0.12$ (6) ただし

NA」: 単レンズの半導体レーザ側(像点側)のNA (開口数) m:倍率

f。: 片方の面に一体化された回折レンズの焦点距離 f。: 単レンズの屈折作用によるレンズの焦点距離

位:nm/度)

の条件を満足するよう構成されているため、先に述べた 効果とともに片面にしか回折格子が一体化されていない ため、より安価なレンズとすることができる。

【0057】また回折素子の2次以上の回折光を用いる ことで、回折格子のピッチを大きくしてより加工を容易 にすることができる。

【0058】また本発明の半導体レーザモジュールによ れば、集光レンズに安価なプラスチックレンズを用いな ンズの両方の屈折面に回折手段を一体化し、集光点側を 40 がら、温度変化に対して安定した結合効率を得ることが できる。さらに、回折効率を集光レンズの回折素子形状 を変えることで制御できるため、光ファイバー端面のア パーチャと組み合わせたシンプルな構造で、半導体レー ザモジュールからの出力を抑え、レーザ光の安全基準を 満たすことができる。

> 【0059】またプラスチックレンズは前記光ファイバ の入射端を固定する固定手段を兼ねるよう一体に成形す るよう構成することで、金属鏡筒や、組立調整の行程を 大幅に省くことができ、非常に安価な半導体レーザモジ 50 ュールを提供することができる。

14

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係るプラスチックレンズの 構成を示す光路図

15

【図2】実施例1の光学性能を示す収差図

【図3】回折素子の格子形状を示す構成図

【図4】本発明の実施例2に係るプラスチックレンズの 構成を示す光路図

【図5】実施例2の光学性能を示す収差図

【図6】本発明の実施例3に係るプラスチックレンズの

構成を示す光路図

【図7】実施例3の光学性能を示す収差図

【図8】本発明の半導体レーザモジュールの一実施例の

構成を示す構成図

\*【図9】本発明の半導体レーザモジュールの別の実施例 の構成を示す構成図

16

【図10】本発明の半導体レーザモジュールのさらに別 の実施例の構成を示す構成図

【図11】従来の半導体レーザモジュールの構成を示す 構成図

【符号の説明】

1 半導体レーザ

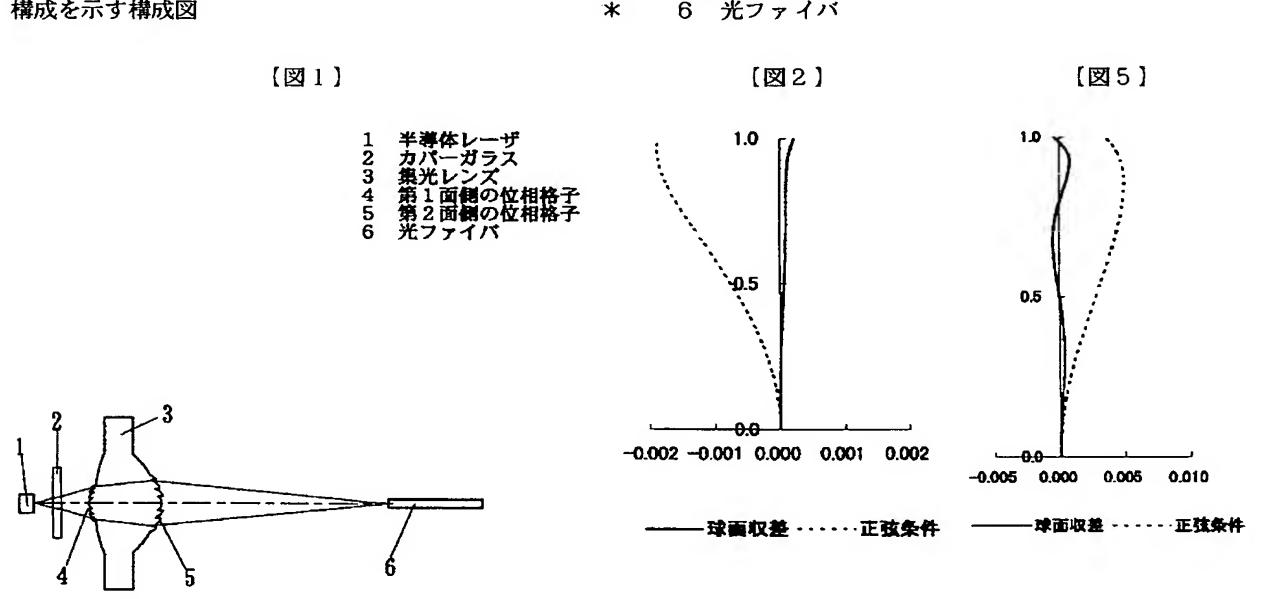
2 カバーガラス

10 3 集光レンズ

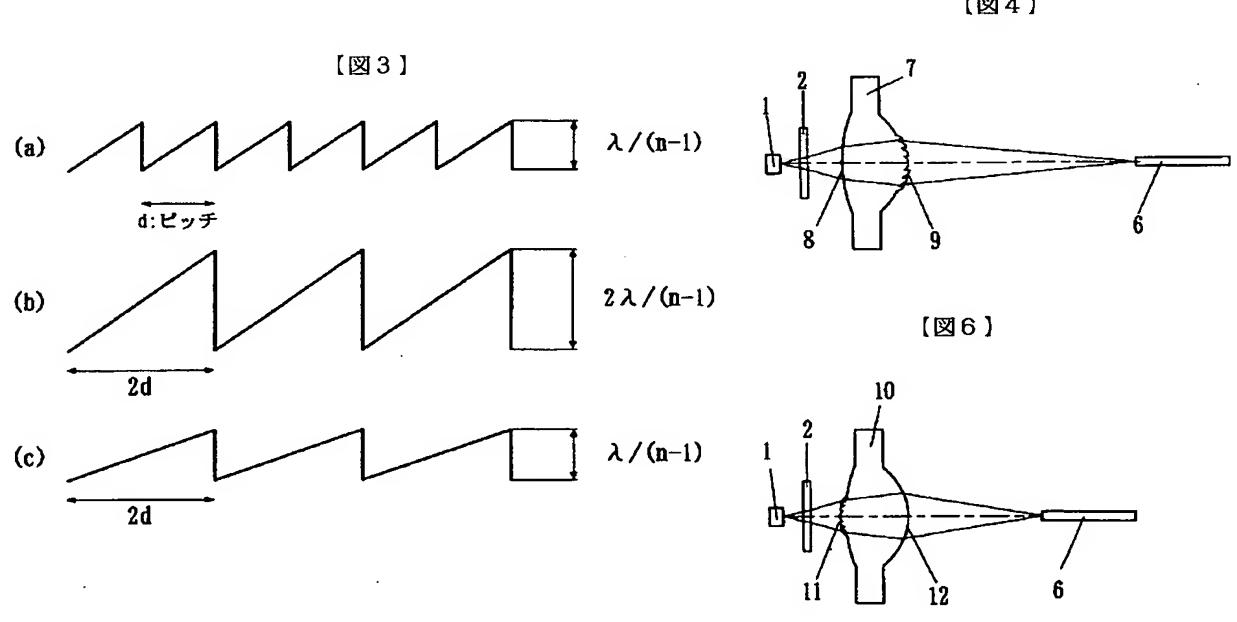
4 第1面側の位相格子

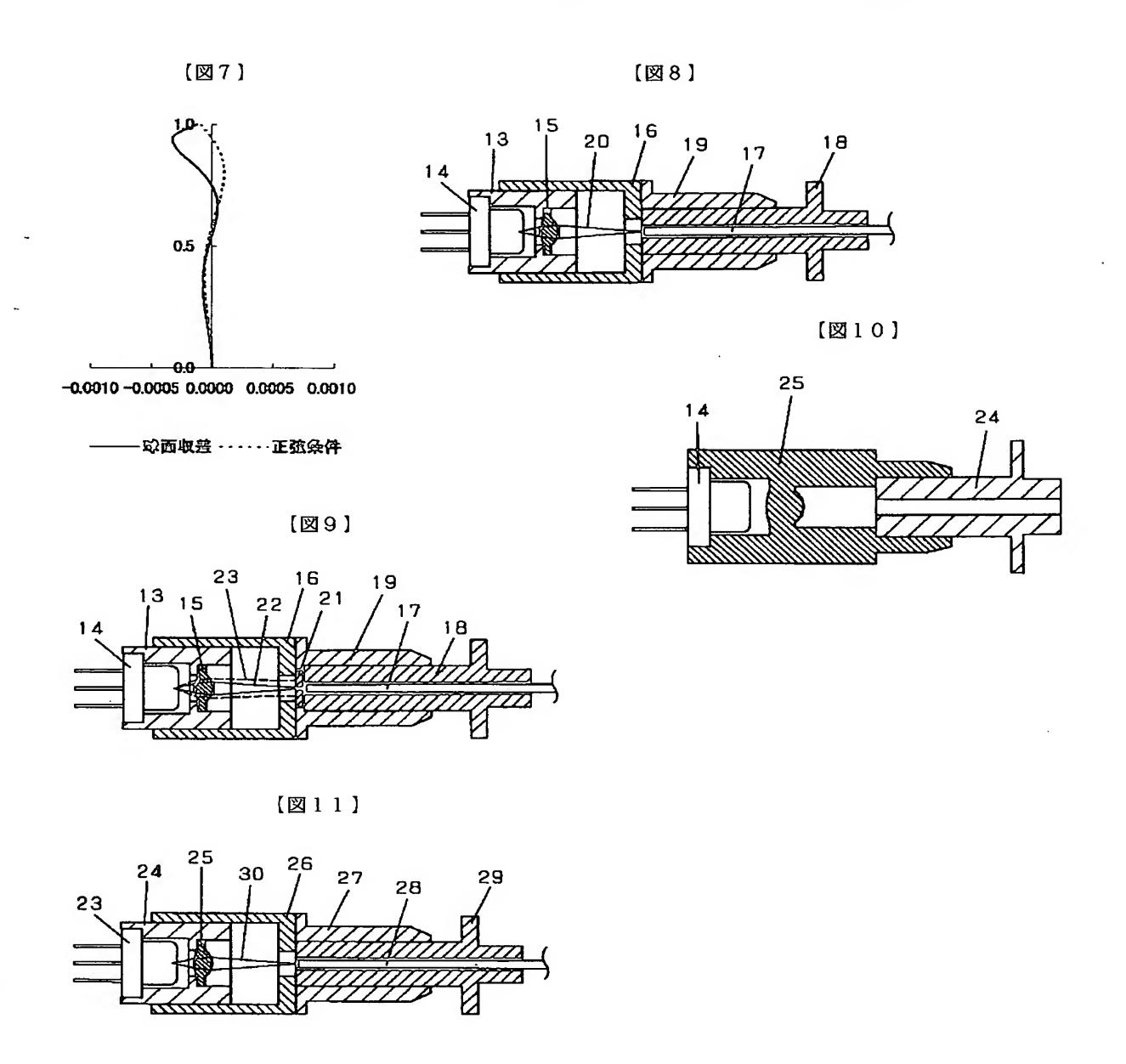
5 第2面側の位相格子

6 光ファイバ



【図4】





フロントページの続き

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>
G02B 13/00

識別記号

FI

13/18

G 0 2 B 13/00

13/18